



## کارشناسی

حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست.

دانشگاه پیام نور

مرکز آزمون و سنجش



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریفی: --

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی / گذ دوس: نرم افزار (سترنی - تجمعی) - سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی: ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندسی  
مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

استفاده از: ماشین حساب ساده مجاز است.

۱. در یک ترانزیستور BJT از نوع PNP ناچالصی کدام قسمت یا قسمت ها از همه بیشتر است؟

ب. امیتر

الف. امیتر و بیس

د. کلکتور و بیس

ج. کلکتور

۲. از نظر ابعاد لایه های ترانزیستور

الف. کلکتور بزرگترین، امیتر متوسط و بیس کوچکترین است.

ب. امیتر بزرگترین، کلکتور متوسط و بیس کوچکترین است.

ج. بیس بزرگترین، کلکتور متوسط و امیتر کوچکترین است.

د. کلکتور بزرگترین، بیس متوسط و امیتر کوچکترین است.

۳. در یک ترانزیستور PNP، مقدار  $I_C = 10\mu A$ ,  $V_T = 25 mV$ ,  $V_{BE} = 0.5$  است. مقدار  $I_S$  چند میکرو آمپر است؟

ب.  $10e^{10}$

الف.  $10e^{20}$

د.  $10e^{-20}$

ج.  $10e^{-10}$

۴. با افزایش درجه حرارت ضریب هدایت نیمه هادی ها:

الف. افزایش می یابد.

ب. کاهش می یابد.

ج. ثابت می ماند

د. در نیمه هادی خالص افزایش و در نیمه هادی ناچالص کاهش می یابد.

۵. در یک اتصال PN هر چه درصد ناچالصی نیمه هادی نوع N و P بیشتر باشد؟

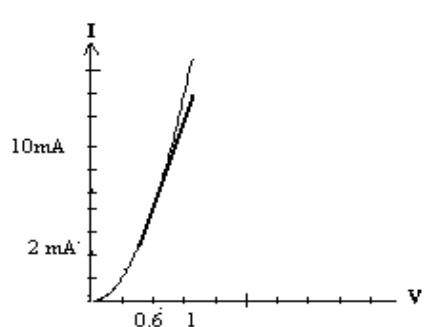
الف. عرض منطقه تخلیه بیشتر است.

ب. عرض منطقه تخلیه کمتر است.

ج. عرض منطقه تخلیه ارتباطی با درصد ناچالصی ندارد.

د. هیچکدام.

۶. با توجه به منحنی مشخصه (I-V) زیر در یک دیود، مقدار  $I$  دیود چند اهم است؟



ب. ۱۰۰

الف. ۵۰

د. ۲۰

ج. ۵



## کارشناسی

حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست.

دانشگاه پیام نور



مرکز آزمون و سنجش

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریفی: --

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

زمان

رشته تحصیلی / گذ دوس: نرم افزار (سترن- تجمیع)- سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی: ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندسی  
مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

مجاز است.

استفاده از: ماشین حساب ساده

۷. کدام گزینه در مورد مقاومت استاتیک دیود صحیح است؟

$$R_S = \frac{\partial V_D}{\partial I_D} \quad \text{ب.} \quad h_{re}$$

$$R_S = \frac{26mV}{I_D} \quad \text{د.} \quad R_S = \frac{\Delta V_D}{\Delta I_D} \quad \text{ج.}$$

۸. دیود نوری.....

الف. با عبور جریان از خود نور ساطه می کند.

ب. یک نوع LED است.

ج. تابش نور به آن باعث افزایش جریان می شود.

د. دارای مقاومت منفی در منحنی مشخصه خود می باشد.

۹. دیود زنر به در کدام مدارها مورد استفاده می باشد؟

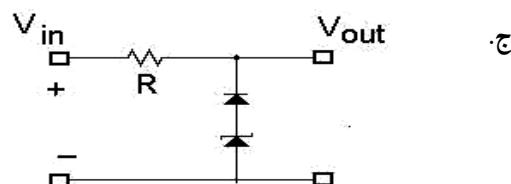
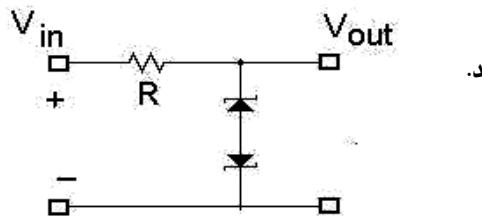
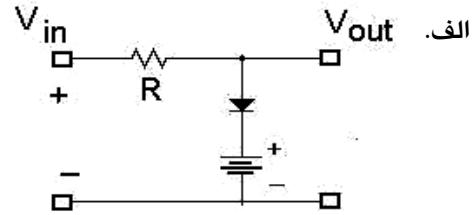
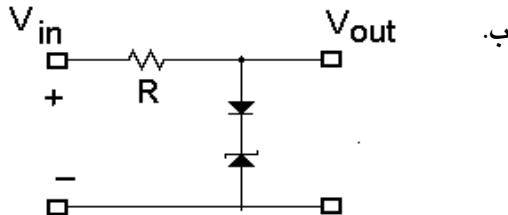
الف. فقط به عنوان رگولاتور ولتاژ در مدارت بکار می رود.

ب. اغلب در مدارهای رگولاتور و گاهی در مدارهای برش دهنده مورد استفاده قرار می گیرد.

ج. به عنوان رگولاتور، برش دهنده و یکسوزان در مدارت بکار می ردد.

د. به عنوان رگولاتور و چند برابر کننده ولتاژ مورد استفاده است.

۱۰. کدام یک از مدارت زیر غیر عملی می باشد؟





## کارشناسی

حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست.

دانشگاه پیام نور



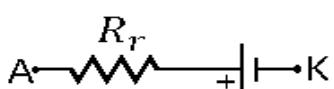
مرکز آزمون و سنجش

تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریفی: --

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی/گذ دوس: نرم افزار (سنتی- تجمعی)- سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی: ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندسی  
مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

استفاده از: ماشین حساب ساده      مجاز است.

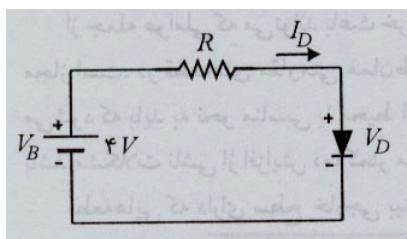


۱۱. مدار معادل دیودی در مدل خطی پاره ایی مطابق روبرو می باشد، این دیود.....

- الف. در حال هدایت است
- ب. ایده ال است.
- ج. به صورت معکوس بایاس شده است.
- د. سوخته است.

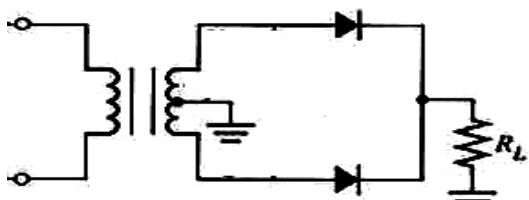
۱۲. در مدار زیر، اگر ولتاژ و جریان نامی دیود سیلیکن به ترتیب  $0.7V$  و  $10mA$  باشد، مقاومت دینامیکی در دمای

$300^{\circ}K$  و در جریان نامی ، چقدر است ؟



- الف.  $33\Omega$
- ب.  $330\Omega$
- ج.  $70\Omega$
- د.  $5.2\Omega$

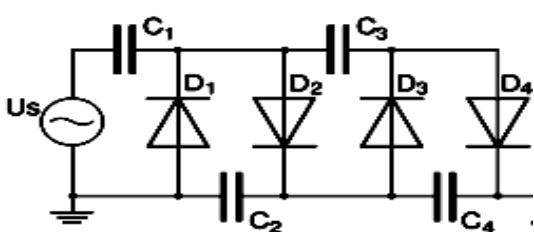
۱۳. در مدار زیر  $V_{dc}$  دو سر مقاومت بار  $V_m = 8.5V$  با فرض  $R_L = 1K$  چند ولت است(دیود ها ایده ال است)؟



- الف.  $2/7$
- ب.  $6/8$
- ج.  $4/7$
- د.  $5/4$

۱۴. بازده یکسوساز نیم موج برابر است با....

- الف.  $\%40$
- ب.  $\%81$
- ج.  $\%75$
- د.  $\%30$



- ۱۵. مدار زیر چه نام دارد؟
- الف. سه برابر کننده ولتاژ
- ب. چهار برابر کننده ولتاژ
- ج. پنج برابر کننده ولتاژ
- د. دو برابر کننده ولتاژ



تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریفی: --

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

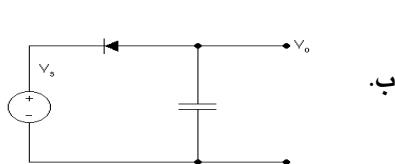
رشته تحصیلی / گذ دوس: نرم افزار (سترنی - تجمعی) - سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی: ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندسی  
مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

استفاده از: ماشین حساب ساده مجاز است.

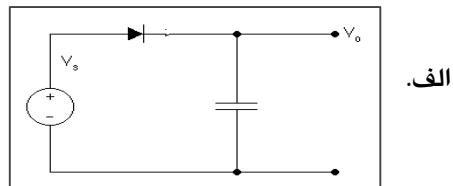
۱۶. فرکانس موج خروجی در یکسوساز تمام موج چقدر است؟

- ب. نصف فرکانس موج ورودی  
الف. برابر فرکانس موج ورودی  
ج. صفر  
د. دو برابر فرکانس موج ورودی

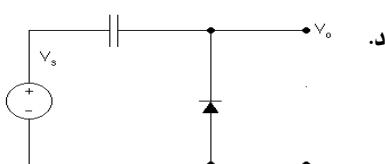
۱۷. می خواهیم سیگنال  $V_m = \sin \omega t$  را به  $V_m + V_m \sin \omega t$  تبدیل کنیم. کدام مدار برای اینکار مناسب است؟



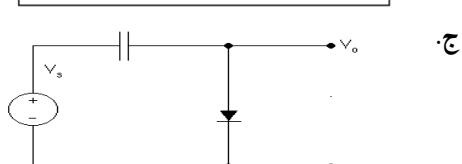
ب.



الف.



د.

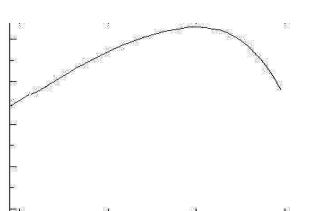


ج.

۱۸. کدام گزینه صحیح است؟

الف.  $I_{CEO}$  همیشه برابر  $I_{CO}$  است.

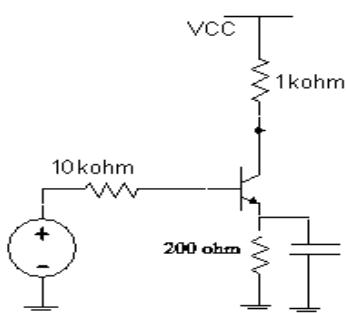
ج. در ناحیه قطع ترانزیستور  $I_E \neq 0$  است.



ب.  $h_{fe} = f(I_C)$   
د.  $V_{BE} = f(h_{fe})$

الف.  $h_{fe} = f(V_{BE})$   
ج.  $V_{BE} = f(I_C)$

۱۹. شکل مقابل کدام منحنی می تواند باشد؟



۲۰. در مدار مقابل ضریب زاویه خط بار DC کدام است؟

الف.  $-\frac{1}{1200}$

ب.  $-\frac{1}{1000}$

ج.  $+\frac{1}{1000}$

د.  $+\frac{1}{1200}$



## کارشناسی

حضرت علی(ع): ارزش هر کس به میزان دانایی و تخصص اوست.

دانشگاه پیام نور

مرکز آزمون و سنجش



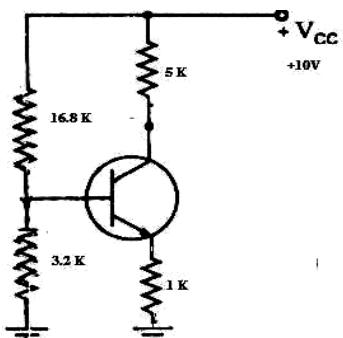
تعداد سوالات: تستی: ۲۵ تشریفی: --

نام درس: مدارهای الکترونیکی - الکترونیک (۱)

رشته تحصیلی/گذ دوس: نرم افزار (سترنی- تجمیع)- سخت افزار: ۱۱۱۵۰۷۰ - مدیریت اجرایی: ۱۳۱۱۰۲۰ - مهندسی برق (مخابرات) - برق (مهندسی پزشکی (بیوالکترونیک)) - مهندسی پزشکی (بالینی): ۱۳۱۹۰۱۹ - رباتی

مجاز است.

استفاده از: ماشین حساب ساده



$$V_{CE} = 0.6V \quad ۲۱.$$

الف. ۲/۵

ب. ۵

ج. ۴

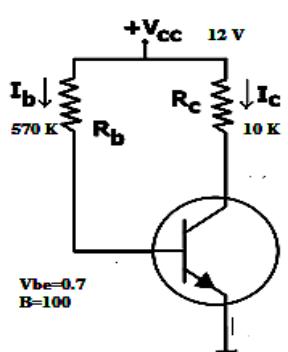
د. ۹

۲۲. جریان کلکتور در مدار روبرو حدوداً چند میلی آمپر است؟

$$V_{CE(sat)} = 0.1V$$

$$V_{BE(on)} = 0.7V$$

$$\beta = 100$$



الف. ۰/۰۲

ب. ۰/۵

ج. ۲

د. ۱/۲

۲۳. در کدام نوع تقویت کننده بین ورودی و خروجی به اندازه ۱۸۰ درجه اختلاف فاز وجود دارد؟

ب. کلکتور مشترک

الف. امیتر فالوور

د. امیتر مشترک

ج. بیس مشترک

۲۴. در مدار معادل h ترانزیستور  $h_{re}$  با کدام رابطه تعریف می شود؟

$$\frac{\Delta V_{BE}}{\Delta V_{CE}} \Big| I_{BQ} \quad \text{ب.}$$

$$\frac{\Delta V_{CE}}{\Delta V_{BE}} \Big| I_{BQ} \quad \text{الف.}$$

$$\frac{\Delta I_C}{\Delta V_{CE}} \Big| V_{BE} \quad \text{د.}$$

$$\frac{\Delta V_{CE}}{\Delta I_C} \Big| V_{BE} \quad \text{ج.}$$

۲۵. در یک تقویت کننده بیس مشترک امپدانس ورودی .... و بهره جریان..... می باشد؟

ب. زیاد - یک

الف. زیاد -  $\beta$

د. کم - یک

ج. کم -  $\beta$

مدار الكترونیکی ترم اول ٩٠\_٩١

ب	1
الف	2
الف	3
الف	4
ب	5
الف	6
الف	7
ج	8
ب	9
ج	10
الف	11
د	12
ج	13
الف	14
ب	15
د	16
د	17
د	18
ب	19
الف	20
ج	21
د	22
د	23
ب	24
د	25